

Seminars

2014-2015

09.06.2015	Mgr. inż. Łukasz Dusanowski	Korelacje emisji fotonów z kompleksów ekscytonowych związanych w kreskach kwantowych InAs/InP.
02.06.2015	Mgr. inż. Andrzej Gawlik	Metrologia tranzystorów typu finFET na bazie półprzewodników grup IV i III/V.
05.05.2015	Dr inż. Anna Musiał	Zwiększenie wydajności nieklasycznych źródeł światła poprzez zastosowanie nowego typu rezonatorów.
28.04.2015	Mgr Henryk Turski	Tajemnice wzrostu InGaN.
14.04.2015	Dr inż. Michał Baranowski	Wpływ stanów lokalizujących na dynamikę rekombinacji promienistej i niepromienistej w nowoczesnych materiałach i strukturach półprzewodnikowych.
31.03.2015	Mgr. inż. Paweł Mrowiński	Wpływ pola magnetycznego na kompleksy ekscytonowe w kreskach kwantowych InAs/InP.
17.03.2015	Mgr. inż. Mateusz Dyksik	Spektroskopia fourierowska struktur przeznaczonych do zastosowania w laserach oraz detektorach pracujących w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni.
03.03.2015	Mgr. inż. Maciej Pieczarka	Widmo wzbudzeń kolektywnych kondensatu polarytonów ekscytonowych.
20.01.2015	Mgr. inż. Agnieszka Noculak	Synteza i właściwości optyczne nanokryształów fluorkowych domieszkowanych jonami lantanowców.
13.01.2015	Mgr. inż. Łukasz Janicki	Badanie rozkładu pól elektrycznych w strukturach półprzewodnikowych na bazie związków III-N.
09.12.2014	Mgr. inż. Bartłomiej Sojka	Funkcjonalizacja oraz badania spektroskopowe nanokryształów fluorkowych domieszkowanych lantanowcami do zastosowań w bio-medycynie.
02.12.2014	Mgr. inż. Filip Dybała	Przestrzajanie diod laserowych z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego.
18.11.2014	Mgr. inż. Monika Węna	Wpływ tlenu na właściwości optyczne półprzewodników grupy II-VI.
04.11.2014	Dr Łucja Marona	Zielone azotkowe struktury laserowe na podłożach półpolarnych GaN - relaksacja naprężeń i fluktuacje składu.

14.10.2014	Dr inż. Joanna Jadczyk	Badania spektroskopowe niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych na bazie GaAs oraz chalcogenków metali przejściowych.
15.09.2014	Alex Luce	Design of Next Generation Full Spectrum Solar Cells Using Intermediate Band Semiconductors.